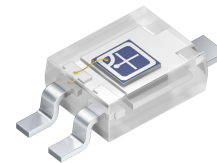


Silicon NPN Phototransistor

NPN-Silizium-Fototransistor

Version 1.1

SFH 3401



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** (typ) 460 ... 1080 nm
- **Package:** Smart DIL
- High linearity
- Available only on tape and reel

Applications

- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Ambient light detector

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** (typ) 460 ... 1080 nm
- **Gehäuse:** Smart DIL
- Hohe Linearität
- Nur gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Lichtschranken
- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln
- Umgebungslichtsensor

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 950 \text{ nm}$, $E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 3401	63 ... 320	Q65110A2635
SFH 3401-2/3	100 ... 320	Q65110A2644

Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)

Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V_{CE}	20	V
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung ($t < 2\text{ min}$)	V_{CE}	70	V
Collector current Kollektorstrom	I_C	50	mA
Collector surge current Kollektorspitzenstrom ($\tau < 10\text{ }\mu\text{s}$)	I_{CS}	100	mA
Emitter-base voltage Emitter-Basis-Spannung	V_{EB}	7	V
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V_{EC}	7	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	120	mW
Thermal resistance for mounting on pcb Wärmewiderstand für Montage auf PC - Board	R_{thJA}	450	K/W

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	(typ)	$\lambda_{S\text{ max}}$	850	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	(typ)	$\lambda_{10\%}$	(typ) 460 ... 1080	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	(typ)	A	0.55	mm ²
Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche	(typ)	L x W	(typ) 1 x 1	mm x mm
Half angle Halbwinkel	(typ)	φ	± 60	°

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent of collector-base photodiode Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode ($E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CB} = 5 \text{ V}$)	(typ)	I_{PCB}	0.28	μA
Photocurrent of collector-base photodiode Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode ($E_V = 1000 \text{ lx}$, Std. Light A, $V_{CB} = 5 \text{ V}$)	(typ)	I_{PCB}	4.8	μA
Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$)	(typ)	C_{CE}	15	pF
Capacitance Kapazität ($V_{CB} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$)	(typ)	C_{CB}	45	pF
Capacitance Kapazität ($V_{EB} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$)	(typ)	C_{EB}	19	pF
Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 10 \text{ V}$, $E = 0$)	(typ (max))	I_{CE0}	3 (≤ 200)	nA

Grouping ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)

Gruppierung

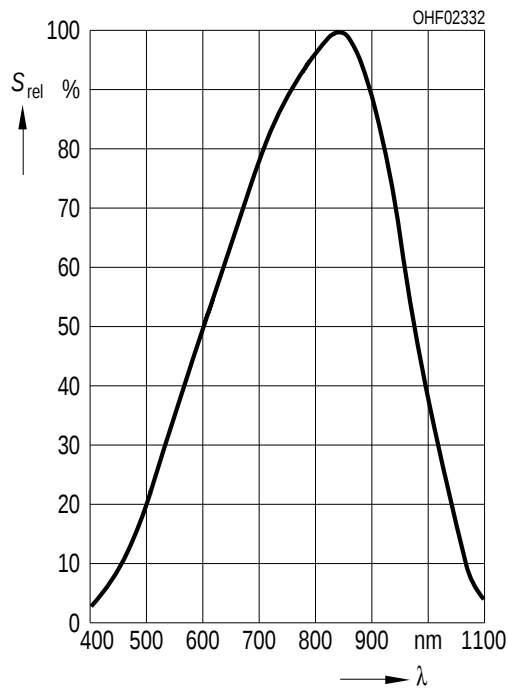
Group Gruppe	Min Photocurrent Min Fotostrom $E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, \min} [\mu A]$	Max Photocurrent Max Fotostrom $E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE, \max} [\mu A]$	Typ Photocurrent Typ Fotostrom $E_V = 1000\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_{PCE} [\mu A]$	Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit $I_C = 1\text{ mA, } V_{CC} = 5\text{ V, } R_L = 1\text{ k}\Omega$ $t_r, t_f [\mu s]$
SFH 3401-1	63	125	1650	16
SFH 3401-2	100	200	2600	24
SFH 3401-3	160	320	4200	34

Group Gruppe	Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung $I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$, $E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$ $V_{CEsat} [\text{mV}]$	Current gain Stromverstärkung $E_e = 0.1\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ I_{PCE} / I_{PCB}
SFH 3401-1	170	340
SFH 3401-2	170	530
SFH 3401-3	170	860

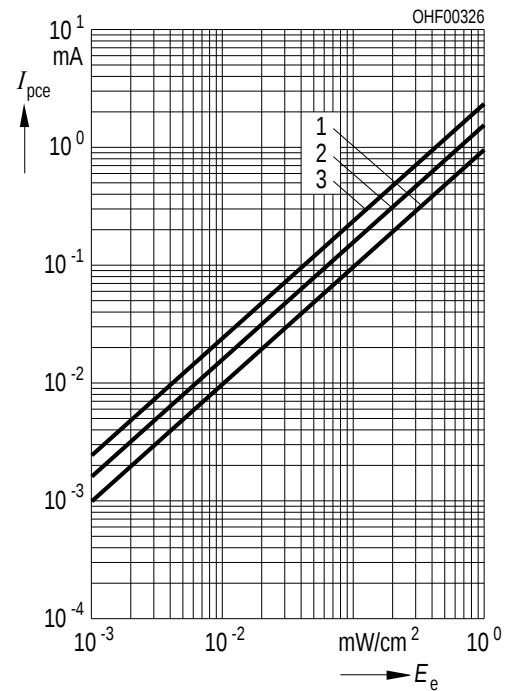
Note.: I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group.Anm.: I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.

Relative Spectral Sensitivity ^{1) page 14}**Relative spektrale Empfindlichkeit** ^{1) Seite 14}

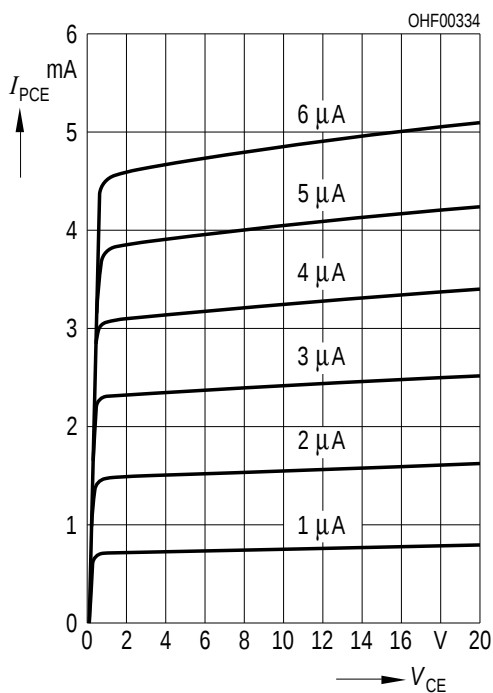
$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$

**Photocurrent** ^{1) page 14}**Fotostrom** ^{1) Seite 14}

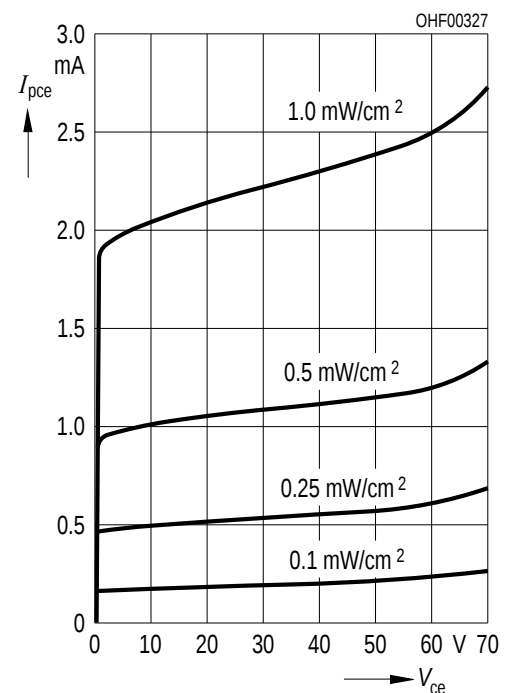
$$I_{\text{PCE}} = f(E_e), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$

**Photocurrent** ^{1) page 14}**Fotostrom** ^{1) Seite 14}

$$I_{\text{PCE}} = f(V_{\text{CE}}), I_B = \text{Parameter}$$

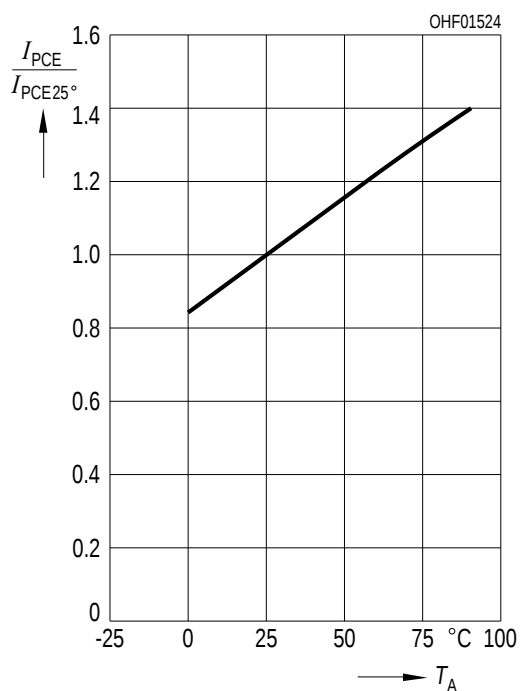
**Photocurrent** ^{1) page 14}**Fotostrom** ^{1) Seite 14}

$$\text{SFH 3401-3 } I_{\text{PCE}} = f(V_{\text{CE}}), E_e = \text{Parameter}$$

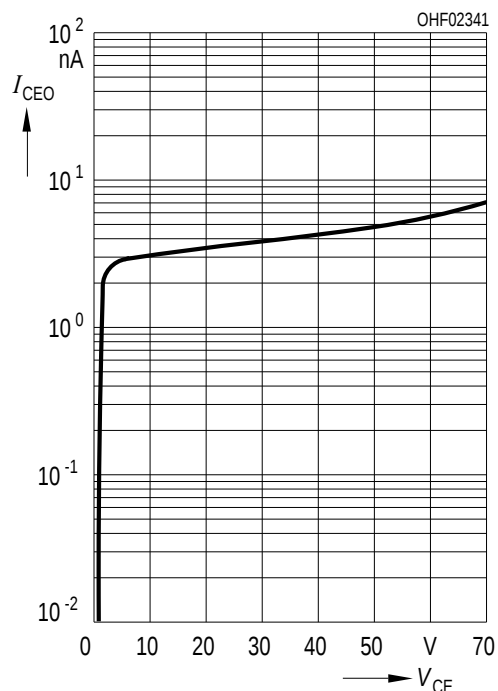


Photocurrent ^{1) page 14}**Fotostrom** ^{1) Seite 14}

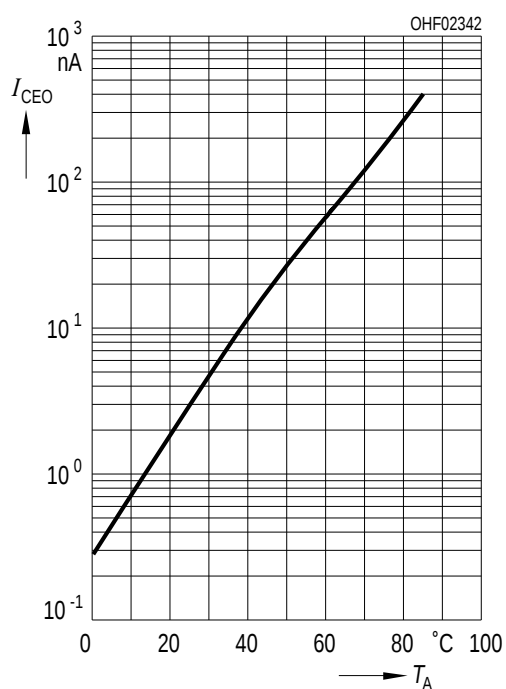
$$I_{PCE} / I_{PCE(25^{\circ}\text{C})} = f(T_A), V_{CE} = 5 \text{ V}$$

**Dark Current** ^{1) page 14}**Dunkelstrom** ^{1) Seite 14}

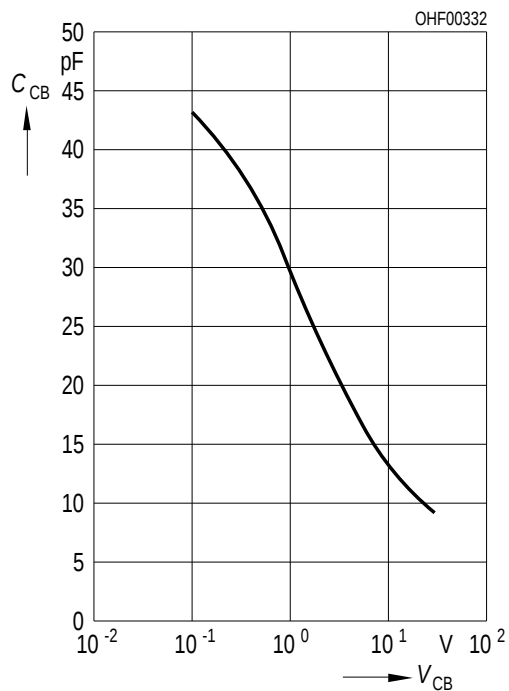
$$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$$

**Dark Current** ^{1) page 14}**Dunkelstrom** ^{1) Seite 14}

$$I_{CEO} = f(T_A), V_{CE} = 10 \text{ V}, E = 0$$

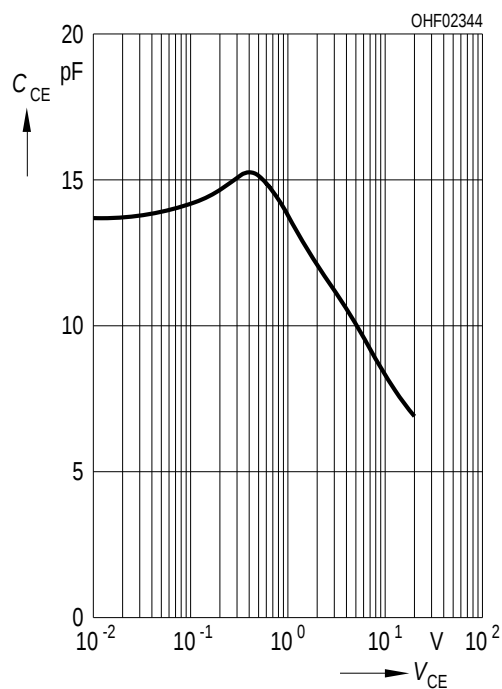
**Collector-Base Capacitance** ^{1) page 14}**Kollektor-Basis Kapazität** ^{1) Seite 14}

$$C_{CB} = f(V_{CB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

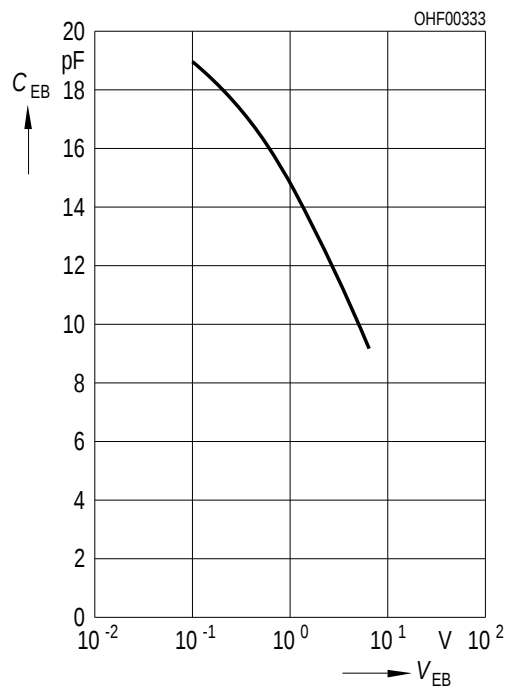


Collector-Emitter Capacitance ^{1) page 14}**Kollektor-Emitter Kapazität** ^{1) Seite 14}

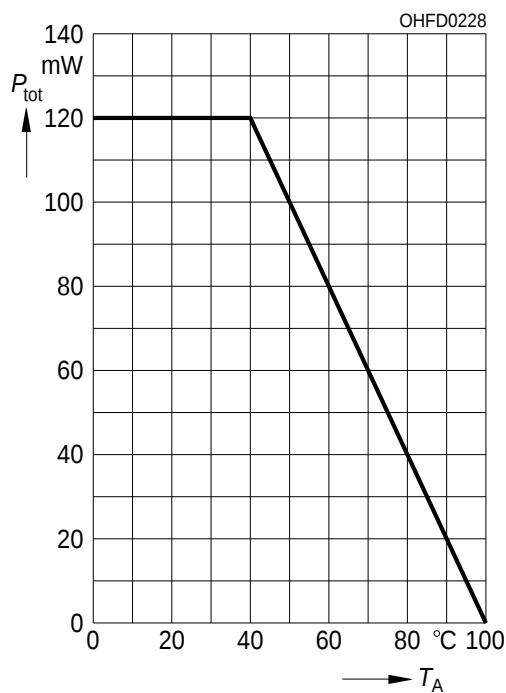
$$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

**Emitter-Base Capacitance** ^{1) page 14}**Emitter-Basis Kapazität** ^{1) Seite 14}

$$C_{EB} = f(V_{EB}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

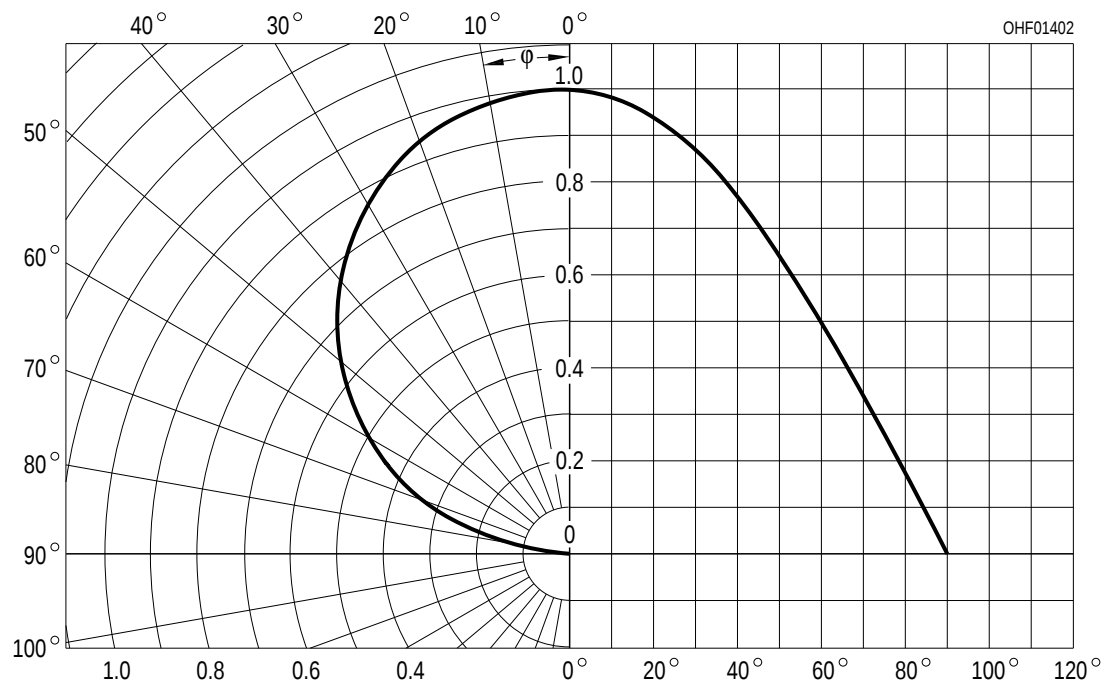
**Total Power Dissipation****Verlustleistung**

$$P_{tot} = f(T_A)$$

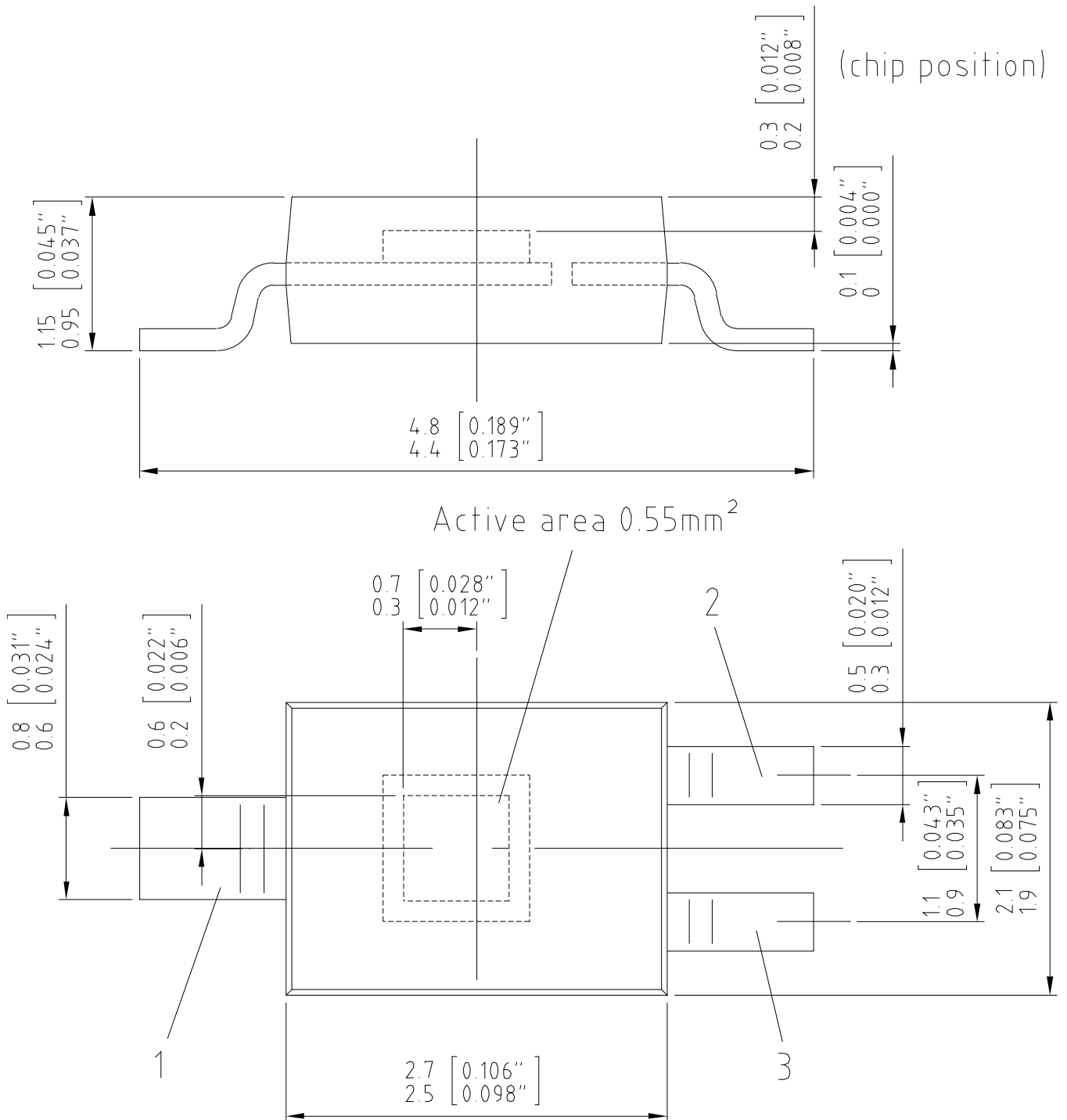


Directional Characteristics ^{1) page 14}
Winkeldiagramm ^{1) Seite 14}

$$S_{\text{rel}} = f(\phi)$$



Package Outline
Maßzeichnung

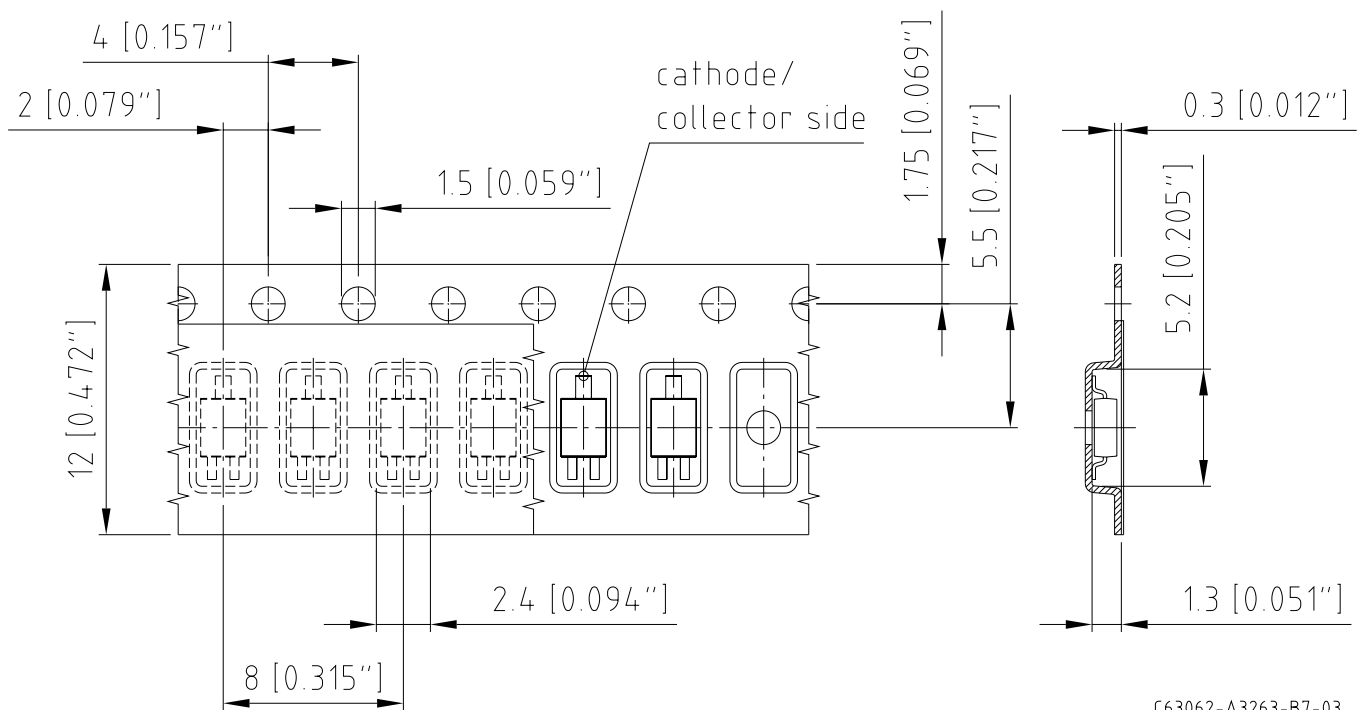


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

C63062-A4002-A2 -03

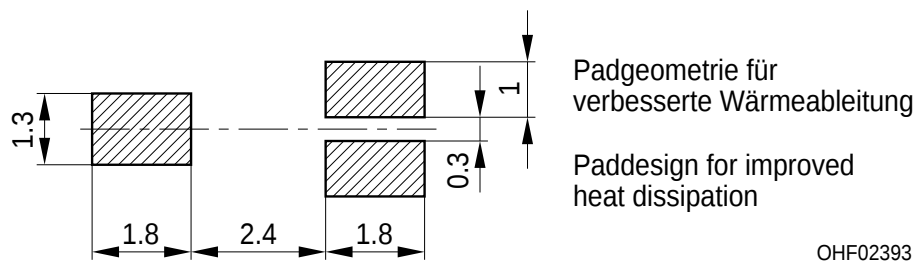
Pinning
Anschlussbelegung

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	collector / Kollektor
2	base / Basis
3	emitter / Emitter

Taping
Gürtung


C63062-A3263-B7-03

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign

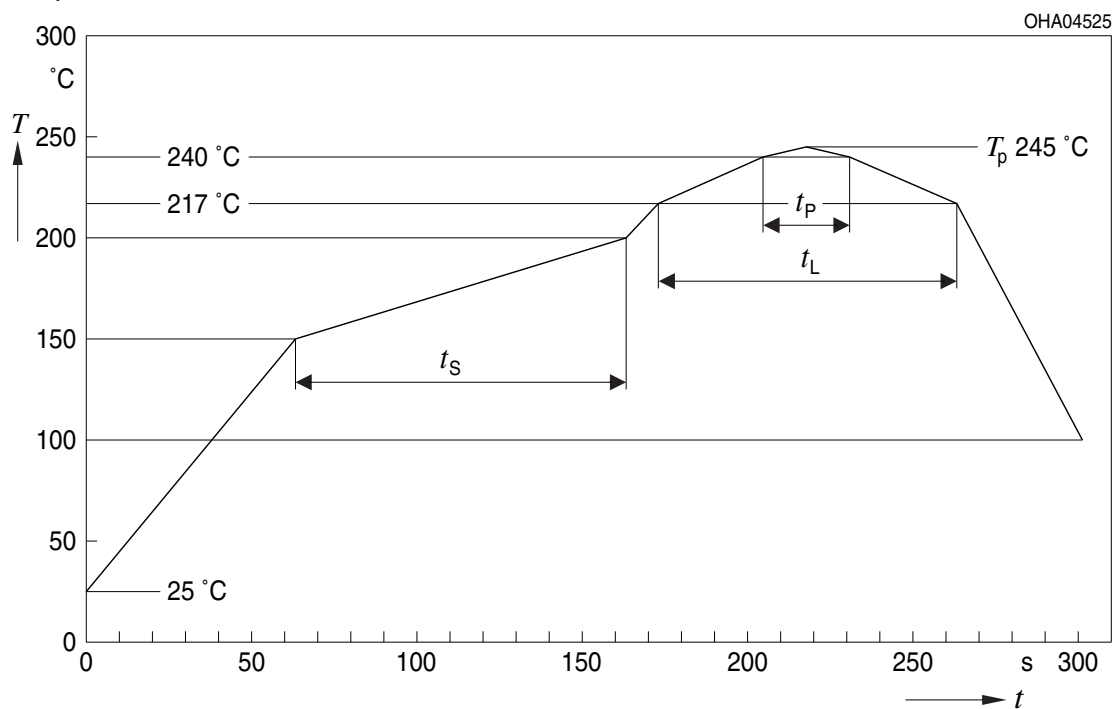


Dimensions in mm. / Maße in mm.

Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- ¹⁾ **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- ¹⁾ **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。